









	<h2 style="color: red;">H11A817B</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	H11A817B
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Datenblätter:	 H11A817B.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2140 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	H11A817B
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	2140 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabotyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	130% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	260% @ 5mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	H11A817BQT

H11A817B ist neu im Original. Suche H11A817B Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A817B AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11A817B: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11A817B Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817ASD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817B300 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817B300 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>
 <p>H11A817B.3SD QTC H11A817B.3SD QTC</p>	 <p>H11A817AW AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817B300W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817ASD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>

heiße Teile

Mehr

 H11A5TVM	 H11A617A3SD	 H11A617A3SD	 D H11A617B	 H11A617B
 H11A617B300	 H11A617B300	 D H11A617B3SD	 H11A617B3SD	 H11A617BS
 H11A617BS	 H11A617BSD	 H11A617BSD	 H11A617CSD	 H11A617CSD
 D H11A617D3SD	 H11A617D3SD	 H11A814C	 H11A817A	 H11A817A
 H11A817A.3SD	 H11A817A3SD	 H11A817A3SD	 H11A817ASD	 H11A817ASD
 H11A817B	 H11A817B.3SD	 D H11A817B300	 H11A817B300	 H11A817B3SD
 H11A817B3SD	 D H11A817BSD	 H11A817BSD	 H11A817BW	 H11A817BW
 H11A817C	 H11A817C	 H11A817C300	 H11A817C300	 H11A817C3SD
 H11A817C3SD	 H11A817CSD	 H11A817CSD	 D H11A817CW	 H11A817CW
 H11A817SD	 H11A817SD	 H11A817X	 H11A817X-5627W	 H11A817X-5632

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

